

P2000

硅 PNP 外延平面晶体管芯片(4 ")

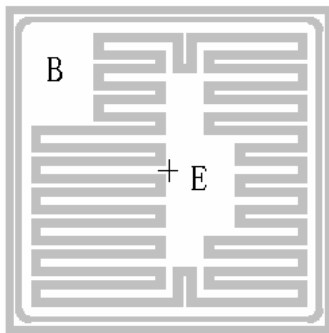
■ 用途:

- * 负电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■ 特征:

- *优越的 h_{FE} 线性
- *与 N2000 配对
- *有效图形数 1800 只

■ 芯片示意图:



■ 芯片结构:

芯片尺寸	2000 μ m \times 2000 μ m
压焊区尺寸	基区: 430 μ m \times 620 μ m 发射区: 430 μ m \times 620 μ m
芯片厚度	270 \pm 20 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
金属层	正面:Al 3.5 \pm 0.4 μ m 背面:Ag 1.4 \pm 0.2 μ m

■ 电特性 (Ta=25°C):

参数名称	符号	测试条件	最小值					最大值	单位
			A	B	C	D	E		
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C = -0.1\text{mA}, I_E = 0$	-80	-100	-150	-180	-220		V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C = -10\text{mA}, I_B = 0$	-60	-80	-120	-150	-200		V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_B = -0.1\text{mA}, I_C = 0$	-7						V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = 0.9BV_{CBO}, I_E = 0$						-1	μ A
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -10\text{V}, I_C = 0$						-1	μ A
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}$	65					350	
集电极-发射极饱和电压	V_{CES}	$I_C = -3\text{A}, I_B = -0.3\text{A}$						-1.5	V
特征频率	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}$	10						MHz